(12)公開特許公報(A)

(19) 日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号 特開2004-282573 (P2004-282573A)

(43) 公開日 平成16年10月7日 (2004.10.7)

| (51) Int.C1. ⁷ | | FΙ | | テーマコード (参考) |
|---------------------------|-------|------|-------|-------------|
| H O 1P | 1/203 | HO1P | 1/203 | 5 J 0 0 6 |
| H O 1P | 7/08 | HO1P | 7/08 | |

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 6 頁)

| (21) 出願番号 | 特願2003-73561 (P2003-73561) | (71) 出願人 | 000004237 |
|-----------|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| (22) 出願日 | 平成15年3月18日 (2003.3.18) | | 日本電気株式会社 |
| | | | 東京都港区芝五丁目7番1号 |
| | | (74) 代理人 | 100109313 |
| | | | 弁理士 机 昌彦 |
| | | (74) 代理人 | 100085268 |
| | | | 弁理士 河合 信明 |
| | | (74) 代理人 | 100111637 |
| | | | 弁理士 谷澤 靖久 |
| | | (72)発明者 | 神内 健寿 |
| | | | 東京都港区芝五丁目7番1号 |
| | | | 日本電気株式会社内 |
| | | F ターム (参 | 考) 5J006 HB01 HB03 HB13 JA03 LA01 |
| | | | LA03 NA08 |
| | | | |
| | | | |

(54) 【発明の名称】低域通過フィルタ

(57)【要約】

【課題】大きさを大きくすることなく、減衰量を大きく とれる低域通過フィルタを提供する。

【解決手段】誘電体基板1の表面にマイクロストリップ ラインで形成された、パターン幅の狭い4本の高インピ ーダンス伝送線路4a、4b、4c、4dと、これと交 互に接続されたパターン幅の広い3本の低インピーダン ス伝送線路3a、3b、3cとから構成される低域通過 フィルタに対して、高インピーダンス伝送線路4a、4 bのそれぞれに、所定の阻止周波数の1/4波長の電気 長を有する2本のオープンスタブ5a、5bとを接続す る。また、2本のオープンスタブは電気長を異なるよう にしても良い。オープンスタブの帯域阻止フィルタの効 果が加わり減衰量を大きくすることができる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】

それぞれマイクロストリップラインで形成される低インピーダンス伝送線路と高インピー ダンス伝送線路とを所定の数だけ交互に接続して成る低域通過フィルタにおいて、前記高 インピーダンス伝送線路に所定の阻止周波数の1 / 4 波長の電気長を有するマイクロスト リップラインで形成されるオープンスタブを接続することを特徴とする低域通過フィルタ

【請求項2】

前 記 オー プンス タ ブ を 所 定 の 阻 止 周 波 数 の 1 / 4 波 長 の 奇 数 倍 の 間 隔 で 前 記 高 イ ン ピー ダ ン ス 伝 送 線 路 に 複 数 本 接 続 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1 記 載 の 低 域 通 過 フ ィ ル タ 。 10

【 請 求 項 3 】

各前記オ - ブンスタブの電気長がそれぞれ異なることを特徴とする請求項 2 記載の低域通 過フィルタ。

【請求項4】

前記オープンスタブの先端部がカギ形であることを特徴とする請求項1、2或いは3記載 の低域通過フィルタ。

【請求項5】

前記オープンスタブの代わりにショートスタブを用いることを特徴とする請求項1,2, 3あるいは4記載の低域通過フィルタ。

【請求項6】

前記マイクロストリップラインの代わりにストリップラインを用いることを特徴とする請 求項1,2,3,4あるいは5記載の低域通過フィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

- 【発明の属する技術分野】
- 本発明は低域通過フィルタに関し、特に無線通信用のマイクロストリップライン型低域通 過フィルタで減衰域の減衰量を大きくした低域通過フィルタに関する。

[0002]

【従来の技術】

この種の低域通過フィルタは、無線周波帯において、所望周波数より高い周波数帯に対し 30 減衰を与えるものである。一般に無線通信装置において、送信側に使用される場合は、送 信増幅器やミキサーなどの非直線形素子の影響で発生する送信信号の高調波などの不要波 の阻止、また、受信側に使用される場合は、送信信号の回り込み成分、受信信号の高周波 帯域に含まれる妨害波などの除去に用いられる。

[0003]

従来、この種の低域通過フィルタの代表例を図 4 に示す。図 4 はマイクロストリップライ ン型の低域通過フィルタの従来例を示す(a)上面図、(b)等価回路図、(c)特性図 である。

[0004]

図4(a)において、本低域通過フィルタは、誘電体基板上に形成された第1~第7のマ 40 イクロストリップライン41~47を有する。低域通過フィルタの入力端である第1のマ イクロストリップライン41の一端は同軸線48に接続され、低域通過フィルタの出力端 である第7のマイクロストリップライン47の一端は同軸線49に接続され、特に第1お よび第7のマイクロストリップライン41,47の線路幅は約800µmに設定されてい る。また、線路幅の広い第2、第4および第6のマイクロストリップライン42,44, 46は、容量性で低インピーダンス伝送線路、線路幅の狭い第3および第5のマイクロス トリップライン43,45は、誘導性で高インピーダンス伝送線路を形成している。 【0005】 図4(b)において、本図は図4(a)の等価回路を示し、図示のように、第1のマイク

ロストリップライン41は、誘電体基板の裏面の接地導体面との間で等価的に容量素子C

50

20

1 を形成する。同様に第2、第4、第6および第7のマイクロストリップライン42,4 4 , 4 6 , 4 7 はそれぞれ、誘電体基板の接地導体面との間で等価的に容量素子 C 2 , C 3 , C 4 , C 5 を形成する。また、第 3 および第 5 のマイクロストリップライン 4 3 , 4 5はそれぞれ、等価的にインダクタ素子し1、し2を形成する。 [0006]図4(b)において、本図は図4(a)の低域通過フィルタの通過特性を示し、所望の周 波数fcより高い周波数帯で減衰特性を示している。 本低域通過フィルタは、図4(b)の等価回路に示したように、LCの5素子を用いた無 極性の低域フィルタ回路を構成するもので、その減衰特性は比較的緩い傾斜のものである 10 [0008]なお、本低域通過フィルタは、同軸線とマイクロストリップラインとの接続点におけるマ イクロストリップライン、即ちマイクロストリップライン41,47を50オーム線路幅 の3倍に設定することにより、同軸線との整合性が良くなり、通過帯域の挿入損失が小さ くなることを特徴とするものである。(例えば、特許文献1参照。) 【特許文献1】 特開2001-217609号公報(第3-4頁) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ 【発明が解決しようとする課題】 20 上述した従来例は、等価回路で示したように無極性の単位低域フィルタ回路を多段構成し たものであるため、減衰特性において、その立ち上がり傾斜が急峻でなく、かつ、減衰量 が小さいという問題がある。この減衰量が小さいという問題については、フィルタ素子の 段数を増やせば改善できるが、他方濾波器の大きさが大きくなるという問題が発生する。 本発明の目的は、大きさを大きくすることなく、減衰量を大きくとれる低域通過フィルタ を提供することにある。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 【課題を解決するための手段】 本発明の低域通過フィルタは、それぞれマイクロストリップラインで形成される低インピ 30 ー ダンス 伝 送 線 路 と 高 イ ン ピ ー ダンス 伝 送 線 路 と を 所 定 の 数 だ け 交 互 に 接 続 し て 成 る 低 域 通過フィルタにおいて、前記高インピーダンス伝送線路に所定の阻止周波数の1 / 4 波長 の電気長を有するマイクロストリップラインで形成されるオープンスタブを接続するよう にする。 **[**0012**]** また、 前 記 オ ー プン ス タ ブ を 所 定 の 阻 止 周 波 数 の 1 / 4 波 長 の 奇 数 倍 の 間 隔 で 前 記 高 イ ン ピーダンス伝送線路に複数本接続するようにしても良い また、各前記オーブンスタブの電気長をそれぞれ異なるようにしても良い。 [0013]また、前記オープンスタブの先端部をカギ形になるようにしても良い。 40 [0014] また、前記オープンスタブの代わりにショートスタブを用いるようにしても良い。 [0015]更に、前記マイクロストリップラインの代わりにストリップラインを用いるようにしても 良い。 [0016]【発明の実施の形態】 次に本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。 図1は、本発明の実施の形態例を示す正面図、図2は、図1の等価回路図、図3は、図1 50

(3)

の特性図である。

【 0 0 1 8 】

先ず、図1を参照して構成を説明する。本低域通過フィルタは、7素子で構成される低域 通過フィルタに2本のオープンスタブを接続した例を示す。

【0019】

その裏面が接地導体面で覆われた誘電体基板1の表面にマイクロストリップラインで形成 された、パターン幅の狭い4本の高インピーダンス伝送線路4a、4b、4c、4dと、 これと交互に接続されたパターン幅の広い3本の低インピーダンス伝送線路3a、3b、 3cと、高インピーダンス伝送線路4a、4bのそれぞれに接続された2本のオープンス タブ5a、5bと、高インピーダンス伝送線路4a、4dのそれぞれに接続され、外部か ら接続される同軸線との整合をとるための入力端伝送線路2と出力端伝送線路6とから構 成されている。

【 0 0 2 0 】

誘電体基板1は、その裏面が接地導体面で覆われおり、その表面に導電性のパターンであるマイクロストリップラインが形成される。マイクロストリップラインの太さを細くすれば誘導性、即ち高インピーダンス伝送線路となり、太くすれば容量性、即ち低インピーダンス伝送線路となる。オープンスタブはこの中間の太さであり、入出力端伝送線路もこの中間の太さで、同軸線のインピーダンス50オームと同じ値のインピーダンスに設定されている。

[0021]

2本のオープンスタブ5a、5bは、所定の阻止周波数の1/4波長の電気長を有し、本 実施例では2本共同じ電気長のものを使用している。また、その先端がカギ形になってい る。このようにすると誘電体基板1の幅寸法を小さくする効果がある。尚、オープンスタ ブの本数は設計条件により増減される。

[0022]

また、2本のオープンスタブ5a、5bは、所定の阻止周波数の1/4波長の間隔で、高インピーダンス伝送線路4a、4dのそれぞれに接続されている。尚、この間隔は1/4 波長の奇数倍であればよいが、本実施例は1倍、即ち1/4波長である。

【0023】

次に図2,3を参照して動作を説明する。

【0024】

図2において、本図は図1の等価回路である。4本の高インピーダンス伝送線路4a、4 b、4c、4dは、等価的にインダクタ素子L1、L2、L3,L4,を形成する。また 、3本の低インピーダンス伝送線路3a、3b、3cは、それぞれ、誘電体基板の接地導 体面との間で等価的に容量素子C1,C2,C3を形成する。2本のオープンスタブ5a 、5bは、インダクタ素子L1、L2のそれぞれの中間点に接続された形態となる。 【0025】

オープンスタブ 5 a 、 5 b は、それぞれ等価的に阻止周波数に共振する直列共振回路に相 当し、阻止周波数でインピ - ダンスが略 0 オームとなり、 この阻止周波数帯域の通過信号 に対して大きな減衰を与える。即ち、帯域阻止濾波器を形成する。

【0026】

この等価回路から明らかのように、通常の無極性の低域通過フィルタに有極性の帯域阻止 濾波器が加わった形となり、オープンスタブの阻止周波数帯域において減衰量が大幅に増 加する。

【0027】

この阻止周波数は、設計条件から決定される。即ち、特に減衰量を大きくしたい周波数帯 域があれば、この帯域の中心周波数に決定される。また、スプリアスなどで特定の周波数 で減衰量の落ち込みがある場合、これを救済するためにこの周波数に設定される場合もあ る。

[0028]

20

10

30

また、減衰帯域全体、或いは幅広い帯域の減衰量を大きくした場合は、オープンスタブを 複数設け、各オープンスタブの阻止周波数を所定の間隔でずらせておくようにする。 [0029]図3は、図1の特性を示すもので、 f1はカットオフ周波数で、 f1以下は通過帯域, f 1以上は減衰帯域を示している。(a)は2本のオープンスタブの電気長、即ち、阻止周 波数を同じf2にしたもので、点線で示した従来例のオープンスタブのない場合に比べ、 2本のオ - プンスタブのf2において大きな減衰量を得ている。 [0030]また、(b)に示したものは、2本のオープンスタブのそれぞれの阻止周波数をf2とf 3 とにずらしたもので、(a)に比べ減衰量は小さくなるが広帯域に減衰量を大きくして 10 いる。 [0031]尚、図1においては、マイクロストリップラインを用いた例で説明したが、マイクロスト リップラインの代わりにストリップラインを用いるようにしても良い。ストリップライン は、マイクロストリップラインの基板表面にもう1枚の片面が 接地導体面で覆われた誘電体基板を、接地導体面を表面にして重ねたような構造で、コス トは高くなるが高周波特性が良くなる利点がある。 [0032]さらに、図1においては、オープンスタブを用いた例で説明したが、オープンスタブの代 わりにショートスタブを用いるようにしても良い。ショートスタブは、オープンスタブが 20 ー 端 は 高 イン ピー ダン ス 伝 送 線 路 に 直 接 接 続 さ れ 、 他 端 は 開 放 さ れ て い る 構 成 に 対 し て 、 一端は高インピーダンス伝送線路に間隙を介し高周波的に接続され、他端はスルーホ・ル を介して基板裏面の接地導体面に接続され接地されている。ショートスタブは、減衰量は 小さくなるが、立ち上がりが急峻な特性を示すので、減衰域の立ち上がり特性の改善に効 果がある。そして、オープンスタブとショートスタブとを混用して所望の減衰特性を得る ようにすることもできる。 [0033]【発明の効果】 以上説明したように本発明は、それぞれマイクロストリップラインで形成される低インピ ーダンス伝送線路と高インピーダンス伝送線路とを交互に接続して成る低域通過フィルタ 30 の高インピーダンス伝送線路に、所定の阻止周波数の1 / 4 波長の電気長を有するオープ ンスタブを接続することにより、オープンスタブの帯域阻止効果が加算され、減衰帯域に おける減衰量を大幅に大きくすることができるという効果がある。あるいは、減衰量を一 定とすれば、回路の素子数を減らすことができるので、大きさを小さくすることができる という効果がある。 【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の実施の形態例を示す正面図である。 【図2】図1の等価図である。 【図3】図1の特性図である。 【図4】従来例を示す(a)正面図、(b)等価回路図、(c)特性図である。 40 【符号の説明】 1 誘電体基板 入力端伝送線路 2 3 a、3 b、3 c 低インピーダンス伝送線路 4 a、4 b,4 c,4 d 高インピーダンス伝送線路 5 a , 5 b オープンスタブ









